

# Silicon NPN Transistor

## **BU107**

300V / 10A

# DATASHEET

OEM – Texas Instruments

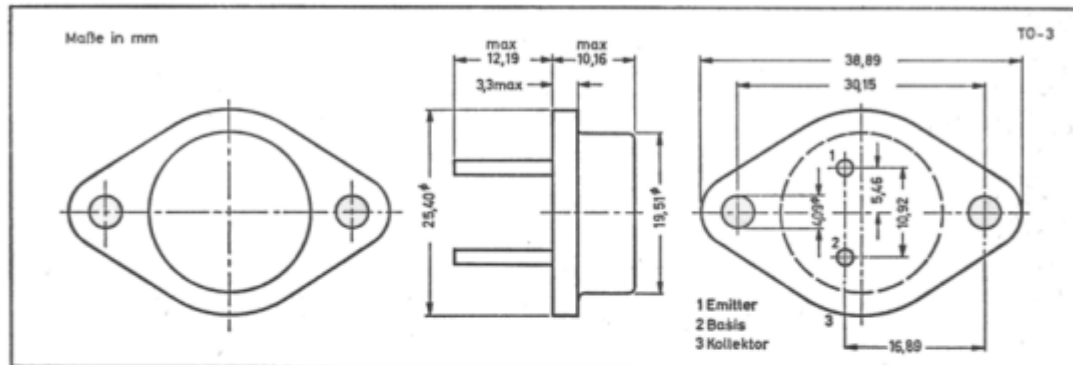
Source: Texas Instruments Databook 1968/69

## BU107

## NPN-Silizium-Leistungstransistor\*\*

Entwickelt für Horizontal-Ablenk-Endstufen

## Mechanische Daten



## Absolute Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung ( $0 \geq U_{BE} \geq -8 \text{ V}$ )	300 V
Emitter-Basis-Spannung	8 V
Kollektorspitzenstrom	10 A
Basisspitzenstrom	5 A
Gehäusetemperatur (im Betrieb)	100 °C
(Anwendung siehe Bem. 1)	

Elektrische Kennwerte bei  $T_G = 25 \text{ °C}$  (wenn nicht anders angegeben)

$I_{CES}$	Kollektor-Emitter-Reststrom	$U_{BE} = 0, U_{CE} = 300 \text{ V}$ (Bem. 2)	$\leq 50 \text{ mA}$
$I_{EBO}$	Emitter-Basis-Reststrom	$U_{EB} = 8 \text{ V}, I_C = 0$	$\leq 10 \text{ mA}$

## Arbeitskennwerte

Impulstest mit  $I_C = 7 \text{ A}, I_{B(\text{ein})} = 1,4 \text{ A}, I_{B(\text{aus})} = 3,0$  (Bem. 1)

$U_{BE(\text{sat})}$	Kollektor-Basis-Sättigungsspannung	$\leq 2 \text{ V}$
$U_{CE(\text{sat})}$	Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$\leq 1,5 \text{ V}$
$t_f$	Kollektorstrom Abfall-Zeit	$\leq 1 \text{ } \mu\text{s}$
$t_s$	Speicherzeit	$\leq 3 \text{ } \mu\text{s}$

## Bemerkungen:

- Für Anwendung in Horizontal-Ablenk-Endstufen.
- Impulstest, Tastverhältnis 2%.

\*\* Vorläufige Daten